



Pressemitteilung

FMS verleiht KIOXIA den Lifetime Achievement Award

Das Entwicklerteam des Unternehmens wird für die Erfindung der BiCS FLASH 3D-Speichertechnologie gewürdigt

Düsseldorf, 25. Juli 2024 – [KIOXIA](#), der Erfinder des NAND-Flashspeichers, erhält für seine Pionierarbeit bei der Entwicklung und Vermarktung von 3D-Flashspeichern den [FMS: the Future of Memory and Storage](#) Lifetime Achievement Award 2024. Die bahnbrechende Technologie ist für eine Vielzahl privater und industrieller Anwendungen wie moderne Smartphones, PCs, SSDs und Rechenzentren von grundlegender Bedeutung. Auch im Kontext künstlicher Intelligenz spielt die leistungsstarke Flashspeichertechnologie eine zentrale Rolle. Das Entwicklerteam von KIOXIA, zu dem Hideaki Aochi, Ryota Katsumata, Masaru Kito, Masaru Kido und Hiroyasu Tanaka gehören, wird die prestigeträchtige Auszeichnung auf der FMS-Konferenz entgegennehmen, die vom 6. bis 8. August in Santa Clara stattfindet.

Erstmals hatte KIOXIA das Konzept des 3D-Flashspeichers BiCS FLASH auf dem VLSI Symposium 2007 vorgestellt. Im Anschluss der Konferenz setzte das Unternehmen die Entwicklung des Prototyps fort, um die Technologie für die Massenproduktion zu optimieren. Im Jahr 2015 brachte KIOXIA schließlich den weltweit ersten 3D-Flashspeicher mit 256 Gigabit (Gb) und 48 Layern auf den Markt.

„KIOXIA hat mit seiner Innovationskraft in Sachen 3D-Flashspeicher den gesamten Bereich der Datenspeicherung revolutioniert.“



Die Experten des Unternehmens haben die Technologie nicht nur weiterentwickelt, sondern zu einer fortschrittlichen Lösung transformiert, die den höchsten Ansprüchen moderner Computertechnologie gerecht wird“, so Chuck Sobey, General Chair der FMS. „Wir freuen uns, diesen wichtigen Beitrag vorstellen zu können und sind gespannt, was die Zukunft bringt.“

Mit seiner 3D-Stacking-Struktur, die sowohl die Kapazität als auch die Leistung steigert, hat der 3D-Flashspeicher BiCS FLASH die Speicherindustrie grundlegend verändert. Dank dieser Technologie konnten Speicherlösungen mit höherer Dichte bei gleichbleibender Zuverlässigkeit und Effizienz entwickelt werden. Das eröffnet nicht nur neue Möglichkeiten im Hinblick auf Rechenzentren, Unterhaltungselektronik und mobile Geräte, sondern setzt auch einen neuen Standard für Flashspeicher. BiCS FLASH nutzt das vertikale Stacking, wodurch die Beschränkungen von planarem NAND-Flash überwunden werden. Das ebnet den Weg für künftige Entwicklungen bei Speicherlösungen und stärkt KIOXIA als Branchenführer im Bereich von 3D-Flashspeichern.

„Unsere technische Innovation im Bereich der 3D-Flashspeicher ist von unschätzbarem Wert“, so Atsushi Inoue, Vice President und Technology Executive der Memory Division bei KIOXIA. „Die Technologie stellt einen Paradigmenwechsel in der Branche dar und ermöglicht es uns, die Speicherdichte in Flashspeichern pro Zelle, Chip und Gehäuse erheblich zu erhöhen. Ich freue mich sehr, dass unsere Leistungen gewürdigt werden, und bin gespannt, welchen Einfluss sie auch in den kommenden Jahren haben werden.“

„Meine Ingenieurskollegen bei KIOXIA sind nicht nur wegen ihrer technologischen Errungenschaften eine Inspiration, sondern auch wegen ihres Engagements, die Branche durch kontinuierliche Innovation und Unterstützung der Entwickler um sie herum voranzubringen“, betont Ryota Katsumata, Senior Fellow des Advanced Memory Development Center bei KIOXIA. „Unsere Beiträge haben nicht nur einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, sondern auch den Geist der Innovation und Zusammenarbeit in der Community gestärkt. Es ist schön zu sehen, dass diese Vorreiterrolle und Vision Anerkennung findet.“



Die 3D-Flashspeicher-Technologie BiCS FLASH wurde 2020 mit dem „Imperial Invention Prize“ der National Commendation for Invention ausgezeichnet, einem staatlichen Programm zur Förderung der Wissenschaft und Technologie in Japan. Sie erhielt überdies 2023 den „Award for Science and Technology“ des „Commendation for Science and Technology“-Programms des japanischen Ministeriums für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie sowie 2021 den IEEE Andrew S. Grove Award.

Anmerkungen:

Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsamen können Marken von Drittunternehmen sein.

Die Informationen in diesem Dokument, einschließlich Produktpreise und Spezifikationen, Inhalt der Dienstleistungen und Kontaktinformationen, sind zum Zeitpunkt der Bekanntgabe gültig, können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Über die KIOXIA Europe GmbH

Die KIOXIA Europe GmbH (ehemals Toshiba Memory Europe GmbH) ist die in Europa ansässige Tochtergesellschaft der KIOXIA Corporation, einem weltweit führenden Anbieter von Flashspeichern und Solid-State-Laufwerken (SSDs). Von der Erfindung des NAND Flash-Speichers bis hin zur Entwicklung des renommierten BiCS FLASH™ 3D-Flashspeichers gilt KIOXIA als Pionier auf dem Gebiet innovativer Speicherlösungen und -dienste, welche das Leben der Menschen bereichern und den Horizont der Gesellschaft erweitern. Die 3D-Flashspeicher-Technologie des Unternehmens, BiCS FLASH™, ist dabei zukunftsweisend für Speicherlösungen für Anwendungen mit hoher Datendichte für moderne Smartphones, PCs, SSDs, Automobilelektronik und Rechenzentren.

Besuchen Sie unsere [KIOXIA-Website](#)

Kontaktaten für die Veröffentlichung:

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Deutschland

Tel.: +49 (0)211 368 77-0

E-Mail: KIE-support@kioxia.com



Pressekontakte:

Hanna Greve, PR-COM GmbH

Tel: +49 (0) 89 59997 756

E-Mail: hanna.greve@pr-com.de

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH

Tel: +49 (0) 211 36877 382

E-mail: lena1.hoffmann@Kioxia.com